

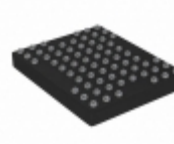







	<h2>TC58BYG0S3HBAI4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58BYG0S3HBAI4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: 1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TC58BYG0S3HBAI4.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3150 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	TC58BYG0S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	3150 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) 63-
Serie	Benand™
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	-
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant

































TC58BYG0S3HBAI4 ist neu im Original, Suche TC58BYG0S3HBAI4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58BYG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58BYG0S3HBAI4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>TC58BVG0S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage TC58BVG0S3HTA00 TOSHIBA</p>	 <p>TC58BVG2S0HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>
 <p>TC58BYG1S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI4JDH TOSHIBA TC58BYG0S3HBAI4JDH TOSHIBA</p>	 <p>TC58BVG2S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BVG2S0HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  TC55V400FT-85 |  TC55V8128BFT-12 |  TC55V8128BJ-12 |  TC55V8512FT-15 |  TC55VBM316ASGN55 |
|  TC55VCM216ASGN55 |  TC55VCM216ASTN55 |  TC55VCM216ASTN55LA |  TC55VZM208AFTN12 |  TC55VZM216AFTN12LA |
|  TC571001D |  TC572502ECTTR |  TC57256AD-12 |  TC57256AD-15 |  TC57512AD-15 |
|  TC58128FT |  TC5816BFT |  TC584000F |  TC58A040F |  TC58BVG0S3HBAI6 |
|  TC58BVG0S3HBAI6 |  TC58BVG0S3HTA00 |  TC58BVG0S3HTA00 |  TC58BVG1S3HTA00 |  TC58BVG1S3HTA00 |
|  TC58BYG0S3HBAI4 |  TC58BYG0S3HBAI4JDH |  TC58C128AFTI |  TC58C256AXB |  TC58DVG02A5TA00 |
|  TC58DVG14B1TG00 |  TC58DVG3S0ETA00/B4J |  TC58DVM72A1FT00 |  TC58DVM72A1TG00 |  TC58DVM72A1XBJ1 |
|  TC58DVM82F1TG10 |  TC58DVM82F1TG10 |  TC58DVM92A1FT |  TC58DVM92A2FT00 |  TC58DVM92A5TA00 |
|  TC58DVM92A5TAJO |  TC58DVM92F1TG10 |  TC58DYG02D5BAI4 |  TC58EVG0S8EBAIB |  TC58F401FT-90 |
|  TC58FVB160AFT-70 |  TC58FVB160FT-10 |  TC58FVB321FT-70 |  TC58FVB800FT-12 |  TC58FVM5B2ATG65 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited